

電子デバイス 半導体電力変換 合同研究会

〔委員長〕鳳 紘一郎(東大)
〔幹事〕益 一哉(東工大)
〔委員長〕斎藤涼夫(東芝)
〔幹事〕小倉常雄(東芝), 千葉 明(東京理科大)
〔幹事補佐〕藤田英明(東工大), 竹下隆晴(名工大)

日時 9月18日(木) 13:30~16:50
19日(金) 9:00~17:00

場所 山口大学工学部(宇部市常盤台2-16-1, 詳細は次のURLを参照ください。
<http://www.eng.yamaguchi-u.ac.jp/index-j.html>)

協賛 パワーデバイス・パワーIC技術調査専門委員会(委員長 関 康和, 幹事 四戸 孝,
高田育紀, 岩室憲幸)

議題 テーマ「パワーデバイス・ICとそのインテリジェント化技術/半導体電力変換一般」

9月18日(木)

EDD-03-44 低損失5GHz帯SOI RFパワーMOSFET

SPC-03-111 松本 聡, 平岡靖史, 三野正人(NIT環境エネルギー研究所)

EDD-03-45 薄膜(0.1 μ m)SOI 構造のフォトリレー用超低 Cout x Ron MOSFET

SPC-03-112 河村圭子, 北川光彦, 古川和由, 倉持信一, 中川明夫, 相沢吉昭(東芝)

EDD-03-46 超低オン抵抗パワーMOS: Super 3D MOS

SPC-03-113 山口 仁, 榊原 純, 鈴木巨裕(デンソー)

EDD-03-47 微細トレンチを用いた超低オン抵抗MOSFET

SPC-03-114 小野昇太郎, 川口雄介, 中川明夫(東芝)

EDD-03-48 TC(Triple Conduction)構造による700V横型MOSFETのドレイン耐圧特性の向上

SPC-03-115 竹花康宏(松下電器)

EDD-03-49 600V Semi-Superjunction MOSFET

SPC-03-116 斉藤 渉, 大村一郎, 相田 聡, 泉沢 優, 小倉常雄(東芝)

9月19日(金) 9:00 ~ 11:50

EDD-03-50 高アバランシェ耐量を有する600V高速NPT-IGBT

SPC-03-117 山口正一, 大村一郎, 浦野 聡, 小倉常雄(東芝)

EDD-03-51 リードフレーム構造を備えた薄ウェハ IGBT の特性改善

SPC-03-118 小野沢勇一, 桐沢光明, 関 康和(富士電機)

大月正人(富士日立パワーセミコンダクタ), 金丸 浩, 池田良成(富士電機総研)

EDD-03-52 p-/n+バッファ層構造の IGBT の検討

SPC-03-119 河路佐智子, 石子雅康, 西脇克彦, 大西豊和(豊田中研, トヨタ自動車)

EDD-03-53 4.5kV-6kA 遮断 IEGT 圧接型パッケージの開発

SPC-03-120 大村一郎, 土門知一, 三宅栄太郎, 崎山陽子, 小倉常雄

日吉道明, 山野伸明, 大橋弘道(東芝)

EDD-03-54 6.5kV-IGBT の寄生動作検証および対策

SPC-03-121 末川英介, 井上雅則, 望月浩一, 川上 稔, 湊 忠玄, 佐藤克巳(三菱電機)

9月19日(金) 13:15 ~ 17:00

EDD-03-55 200V MR-TMOS

SPC-03-122 黒崎 徹, 宍戸寛明, 北田瑞枝, 大島浩介, 九里伸治, 菅井昭彦(新電元工業)

EDD-03-56 最近の IGBT 二次破壊解析例に関する論評

SPC-03-123 高田 育紀(三菱電機)